



9707270

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16555.6—1996

## 碳化硅耐火材料化学分析方法 测定二氧化硅量

Chemical analysis for silicon  
carbide refractories—  
Determination of silicon dioxide



C9707270

1996-09-27发布

1997-03-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国  
国家标准  
**碳化硅耐火材料化学分析方法**  
**测定二氧化硅量**

GB/T 16555.6—1996

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
电 话：68522112  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权所有 不得翻印

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 12 千字  
1997 年 4 月第一版 1997 年 4 月第一次印刷  
印数 1—2 000

\*  
书号：155066·1-13591 定价 6.00 元

\*  
标目 306—56

9707270

GB/T 16555.6—1996

## 前　　言

本标准参考罗马尼亚标准 STAS9281/5—74《碳化硅耐火材料 二氧化硅量的测定》中第一种方法。

为了保护铂坩埚,本标准以无水碳酸钠和硼酸配制成的混合熔剂代替无水碳酸钠与硝酸钾为熔剂分解试样。

由于游离硅量的测定是本系列标准中的一个独立部分,本标准在计算二氧化硅的公式中减去了游离硅。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:冶金工业部洛阳耐火材料研究院。

本标准起草人:黄卫国、李丽萍。



# 中华人民共和国国家标准

## 碳化硅耐火材料化学分析方法 测定二氧化硅量

GB/T 16555.6—1996

Chemical analysis for silicon carbide refractories—  
Determination of silicon dioxide

### 1 范围

本标准规定了测定二氧化硅量的方法提要、试剂和材料、仪器设备、试样、分析步骤、分析结果的表述及允许差。

本标准适用于 SiC≤15% 的碳化硅耐火材料中二氧化硅量的测定。

测定范围：二氧化硅≥20.00%。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2007.1—87 散装矿石产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T 2007.2—87 散装矿石产品取样、制样通则 手工制样方法

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 10325—88 耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则

### 3 方法提要

试料用混合熔剂熔融，盐酸浸取，加热浓缩至湿盐状，加甲基纤维素凝聚，将沉淀洗涤、过滤并灼烧至恒量。用氢氟酸除硅后再次灼烧至恒量。以两次的质量差作为试料的主硅量。再将残渣熔融浸出，合并到主硅滤液中，以钼兰光度法测定其残硅量。主硅量与残硅量之和即为试料总硅量。由试样总硅量减去其碳化硅和游离硅的量计算出二氧化硅量。

### 4 试剂和材料

4.1 混合熔剂：4份质量的无水碳酸钠与1份质量的硼酸研细并混匀。

4.2 盐酸( $\rho=1.19\text{ g/cm}^3$ )。

4.3 盐酸(1+5)。

4.4 盐酸(5+95)。

4.5 硫酸(1+1)。

4.6 氢氟酸( $\rho=1.13\text{ g/cm}^3$ )。

4.7 甲基纤维素(1.5 g/L)：称取 0.15 g 甲基纤维素于塑料杯中，加 100 mL 水溶解，放置 4 h 后使用，用前摇匀。

4.8 硝酸银溶液(10 g/L)。

4.9 钼酸铵[( $\text{NH}_4$ )<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> · 24H<sub>2</sub>O]溶液(50 g/L)。

国家技术监督局 1996-09-27 批准

1997-03-01 实施

4.10 硫酸亚铁铵[ $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ]溶液(40 g/L):称取4g硫酸亚铁铵溶于水中,加5mL硫酸(4.5),用水稀释至100mL,混匀、过滤。

4.11 混合酸:称取15g草酸( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )溶于250mL硫酸(1+8)中,用水稀释至1000mL。

4.12 二氧化硅标准贮存液(1.0000 mg/mL):称取0.5000g预先在1000℃灼烧2h并冷至室温的二氧化硅(99.99%)于铂坩埚内,加4g无水碳酸钠混匀,再覆盖1g无水碳酸钠,盖上坩埚盖并稍留缝隙,于1000℃高温炉内熔融5~10min后取出冷却,置于聚四氟乙烯烧杯中,用100mL沸水浸取,用热水洗出坩埚和盖,冷至室温后移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀后移入塑料瓶中保存。

4.13 二氧化硅标准溶液(0.0100 mg/mL):移取5.00mL二氧化硅标准贮存液(4.12)于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀后移入塑料瓶中。

## 5 仪器设备

5.1 天平(精度0.0001g)。

5.2 分光光度计。

5.3 铂坩埚(30mL)。

## 6 试样

### 6.1 实验室样品的采制

对定型制品,按GB 10325—88第3章采样,在切(钻)取有关的物理检验用试样后,将剩余部分的表皮除去,然后各取100g以上,合并作为实验室样品;对不定形材料,可按GB 2007.1和GB 2007.2分别进行采样和制样。

### 6.2 试样的制备

对定型制品,将6.1所得实验室样品全部破碎至2.0mm以下,缩分出100g。再用钢研钵击碎至0.9mm以下,缩分出25g,然后用钢研钵反复击碎至全部通过0.088mm筛,并用磁铁吸除引入的铁;对不定形材料,从6.1所得实验室样品中缩分出25g,用钢研钵反复击碎至全部通过0.088mm筛,用磁铁吸除引入的铁。

最后将试样于110℃烘2h,置于干燥器中冷至室温。

## 7 分析步骤

### 7.1 试料

称取0.25~0.50g试样,精确至0.0001g,用二份试料进行测定。

### 7.2 空白试验

随同试样作一次空白试验。

### 7.3 校正试验

随同试样分析同类标准样品。

### 7.4 测定

7.4.1 将试料置于铂坩埚(5.3)内,放入1100℃高温炉内烧10~15min,取出冷却。加2g混合溶剂搅匀,再覆盖0.5g混合熔剂,加盖并稍留缝隙,先于750~800℃高温炉内加热30min,再将炉温逐渐升至1100℃,待试样完全分解,取出,旋转坩埚使熔体附着于埚壁内冷却。

7.4.2 将坩埚直立于200mL烧杯中,加20mL水于坩埚中,浸泡3h,加10mL盐酸(4.2)于烧杯中,用水将坩埚外壁和埚盖洗净。向坩埚内加入12mL盐酸(4.3),于电炉板上加热浸取残余熔体,将坩埚内的溶液并入原烧杯中,将坩埚洗净。往烧杯中加入8mL盐酸(4.2),于电炉板上低温加热浓缩至湿盐状态,取下,冷却,加2mL盐酸(4.2)搅拌,加少许纸浆和3mL甲基纤维素溶液搅拌1min,放置5min后用中速定量滤纸过滤,滤液承接于250mL容量瓶中,用热盐酸(4.4)洗涤烧杯和玻棒,用一小片滤纸

擦洗，使沉淀全部转移到滤纸上。用热盐酸(4.4)将沉淀洗至白色，再用热水洗至无氯离子(用硝酸银溶液检查)。

7.4.3 将所得沉淀连同滤纸包好，放入铂坩埚(5.3)内，小心烘干、灰化。置于500℃高温炉中，逐渐升至1050~1100℃，灼烧1h，取出置于干燥器中冷至室温，称量。反复灼烧(每次15min)至恒量。

7.4.4 灼烧后的沉淀用水润湿，加硫酸(4.5)4滴，加氢氟酸5mL，于电炉板上低温蒸发至冒尽白烟。然后置于1050~1100℃高温炉内灼烧15min，取出，置于干燥器中冷至室温后称量。如此反复操作，直至恒量。

7.4.5 于盛有残渣的坩埚(7.4.4)中加0.5g混合熔剂，于1050~1100℃高温炉内熔融2~3min，取出，冷却。加6mL盐酸(4.3)于铂坩埚内，于电炉板上加热浸取，溶液并入原滤液(7.4.2)中，用水稀释至刻度，摇匀。

7.4.6 移取10.00mL溶液(7.4.5)于100mL容量瓶中，加10mL水和5mL钼酸铵(4.9)，摇匀，放置10~30min。加30mL混合酸(4.11)，立即加入5mL硫酸亚铁铵(4.10)，用水稀释至刻度，摇匀。

7.4.7 用3cm比色皿，于分光光度计波长690nm处，以空白溶液(6.2)为参比，测量其吸光度，然后从工作曲线(7.5)上查出对应的二氧化硅量。

## 7.5 工作曲线的绘制

移取0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL标准溶液(4.13)于一组100mL容量瓶中，加2.5mL盐酸(4.3)，加水至20mL，以下按7.4.6和7.4.7，以试剂空白作参比测量其吸光度，绘制标准曲线。

## 8 分析结果和表述

### 8.1 分析值的计算

#### 8.1.1 按式(1)计算总硅的质量百分数 SiO<sub>2T</sub>：

$$\text{SiO}_{2T}(\%) = \frac{m_1 - m_2 + m_3}{m \times \frac{10}{250}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中： $m_1$ ——氢氟酸处理前沉淀与坩埚的质量，g；

$m_2$ ——氢氟酸处理后沉淀与坩埚的质量，g；

$m_3$ ——从工作曲线上查得的二氧化硅量，g；

$m$ ——试料的量，g。

所得结果按GB 8170的进舍规则修约至小数第二位。

#### 8.1.2 按式(2)计算二氧化硅的质量百分数 SiO<sub>2</sub>：

$$\text{SiO}_2(\%) = \text{SiO}_{2T} - \text{SiC} \times 1.498 - \text{Si} \times 2.14 \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中：SiC——试样中碳化硅量，%；

Si——试样中游离硅量，%；

1.498——碳化硅换算成二氧化硅的系数；

2.14——游离硅换算成二氧化硅的系数。

所得结果按GB 8170的进舍规则修约至小数第二位。

### 8.2 分析值的验收

检查校正试验中标准样品的分析值与其标准值是否一致。只有当标准样品的分析值与其标准值一致时，试样中该成分的分析值才有效，方能按8.3进行该成分最终结果的计算，否则应重新进行该成分的测定。

### 8.3 最终结果的计算

当所得的二个有效分析值之差的绝对值不大于其对应的允许差(见表1)时,计算其算术平均值,按GB 8170的进舍规则修约至小数第二位作为该成分的最终结果,否则按附录A(标准的附录)进行追加分析和数据处理,以所得平均值按GB 8170的进舍规则修约至小数第二位作为该成分的最终结果。

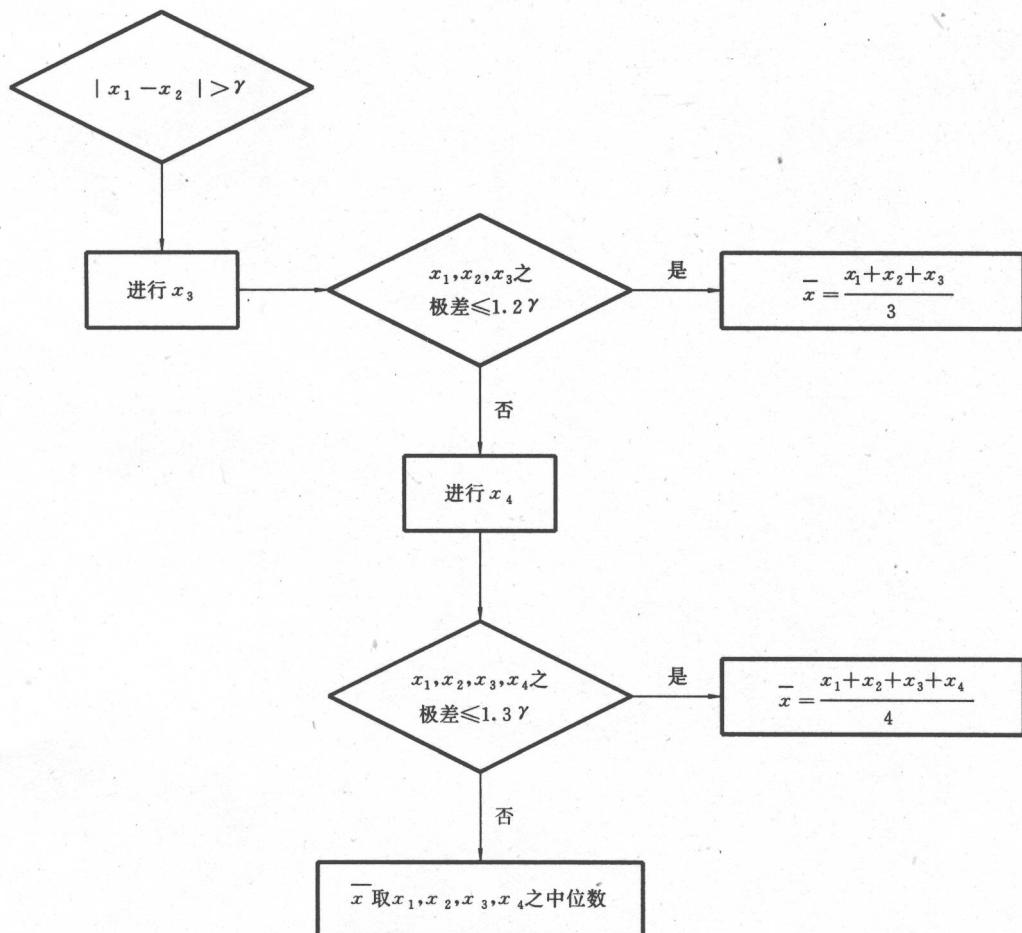
## 9 允许差

在重复性条件下所得二个单次分析值的允许差见表1。

表1 允许差

含量范围	允许差	%
20.00~50.00	0.50	
50.01~80.00	0.70	

**附录 A**  
**(标准的附录)**  
**追加分析和数据处理程序**



上述:  $x_i$ ——单次分析值;

$\gamma$ ——允许差。